

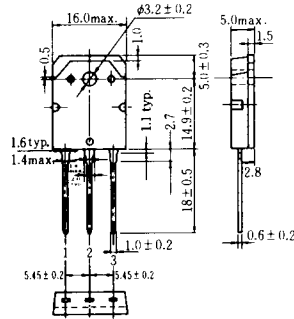
2SD1597

シリコン NPN 三重拡散形

低周波電力増幅用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

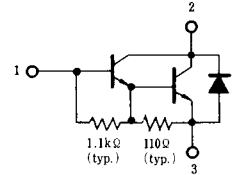
LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER



(TO-3P)

1. ベース : Base
2. コレクタ : Collector (フランジ) (Flange)
3. エミッタ : Emitter

(Dimensions in mm)



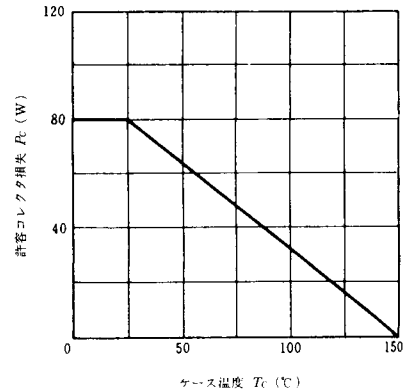
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SD1597	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	120	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	120	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	I_C	30	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	45	A
逆コレクタ電流	$-I_C$	30	A
許容コレクタ損失	P_C^*	80	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=0.1\text{mA}$, $I_E=0$	120	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=50\text{mA}$, $I_C=0$	7	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=100\text{V}$, $I_E=0$	—	—	10	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=2\text{V}$, $I_C=15\text{A}^*$	1000	—	—	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=2\text{V}$, $I_C=30\text{A}^*$	800	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=30\text{A}$, $I_B=0.1\text{A}^*$	—	—	2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(\text{sat})}$	$I_C=30\text{A}$, $I_B=0.1\text{A}^*$	—	—	2.5	V
エミッタ・コレクタ電圧	V_{ECF}	$I_F=15\text{A}^*$	—	—	2.0	V
ターンオフ時間	t_{off}	$I_C=15\text{A}$, $I_{B1}=-I_{B2}=50\text{mA}$	—	7.0	—	μs

*パルス測定

* Pulse Test